

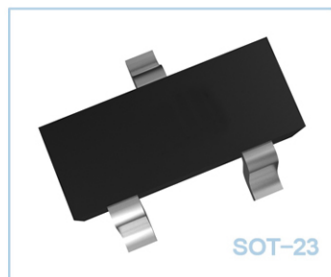
最大额定值/MAXIMUM RATINGS

参数 Parameter	符号 Symbol	额定值 Rating	单位 Unit
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	20	V
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	V_{CBO}	40	V
发射极-基极电压 Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
集电极直流电流 Collector Current	I_C	600	mA
总耗散功率($T_A=25^\circ\text{C}$)* Total Device Dissipation($T_A=25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	225	mW
结到环境的热阻 Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{(th)ja}$	556	$^\circ\text{C}/\text{W}$
工作结温 Junction Temperature(Max)	T_j	150	$^\circ\text{C}$
贮存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

* 器件安装在印制电路板上

Device mounted on a printed circuit board.

NPN-硅通用晶体管
GENERAL PURPOSE
TRANSISTOR NPN SILICON
225mW、600mA、20V



DEVICE MARKING

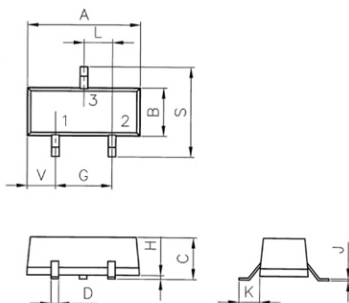
S8050 =J3Y

电性能/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A=25^\circ\text{C}$)

参数名称 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test condition	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
击穿电压 Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}, I_B=0$	20	—	—	V
	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$	40	—	—	V
	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$	5.0	—	—	V
集电极截止电流 Collector-Cutoff Current	I_{CBO}	$V_{CB}=25\text{V}, I_E=0$	—	—	100	μA
直流放大系数 DC Current Gain	h_{FE}	$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=1.0\text{V}$	100	—	250	—
集电极-发射极饱和电压 Collector- Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	—	—	0.60	V
基极-发射极饱和电压 Base - Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C=600\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	—	—	1.2	V

SOT-23外形尺寸

单位: mm



尺寸 符号	SOT-23	
	min	max
A	2.80	3.04
B	1.20	1.40
C	0.89	1.13
D	0.30	0.50
G	1.80	2.04
H	0.01	0.10
J	0.08	0.18
K	0.45	0.60
L	0.89	1.02
S	2.10	2.50
V	0.42	0.60